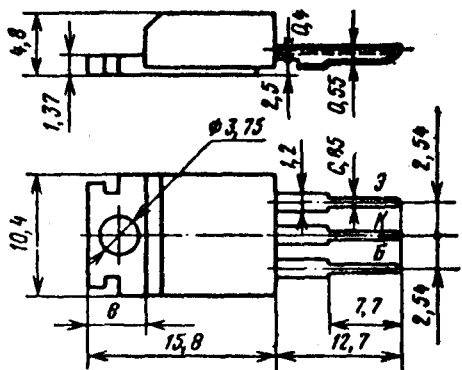


КТ829 (А, Б, В, Г)

Транзисторы кремниевые меза-планарные структуры *n-p-n* составные усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, переключающих устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 2 г.

КТ829 (А-Г)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ}=3$ В, $I_k=3$ А, не менее:

$T_k = +25...+85^\circ\text{C}$	750
$T_k = -40^\circ\text{C}$	100

Модуль коэффициента передачи тока при $U_{кэ}=3$ В, $I_k=3$ А, $f=10$ МГц, не менее 0,4

Граничное напряжение при $I_k=100$ мА, не менее:

КТ829А	100 В
КТ829Б	80 В
КТ829В	60 В
КТ829Г	45 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_k=3,5$ А, $I_b=14$ мА, не более 2 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_k=3,5$ А, $I_b=14$ мА, не более 2,5 В

Обратный ток коллектор — эмиттер при $U_{кэп}=U_{кэп, макс}$, $R_{бэ} \leq 1$ кОм, не более:

$T_k = +25$ и -40°C	1,5 мА
$T_k = +85^\circ\text{C}$	3 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{бэ}=5$ В, не более 2 мА

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб}=U_{кб, макс}$, не более 120 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{бэ} \leq 1$ кОм, постоянное напряжение коллектор — база.

КТ829А	100 В
КТ829Б	80 В
КТ829В	60 В
КТ829Г	45 В

Постоянное напряжение база — эмиттер 5 В

Постоянный ток коллектора 8 А

Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 500$ мкс, $Q \geq 10$ 12 А

Постоянный ток базы 0,2 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_k = -40...+25^\circ\text{C}$ 60 Вт

Тепловое сопротивление переход — корпус $2,08^\circ\text{C/Вт}$

Температура *p-n* перехода $+150^\circ\text{C}$

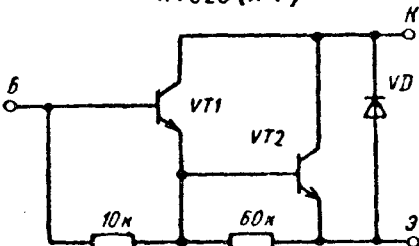
Температура окружающей среды -40°C . $T_k = +85^\circ\text{C}$

¹ При $T_k = +25, +85^\circ\text{C}$ $P_{к макс}$ рассчитывается по формуле

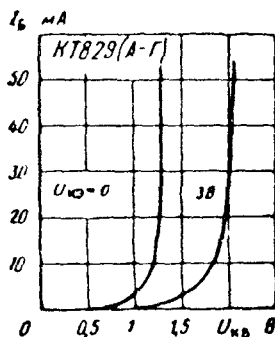
$$P_{к макс} \text{ Вт} = (150 - T_k) / 2,08$$

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса, при этом температура корпуса не должна превышать $+85^\circ\text{C}$

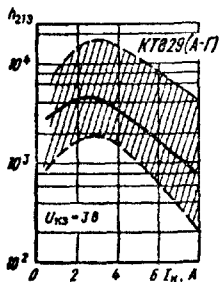
КТ829 (А-Г)



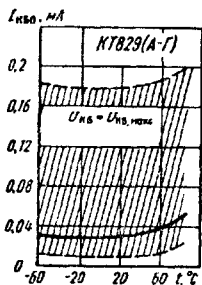
Электрическая схема транзистора



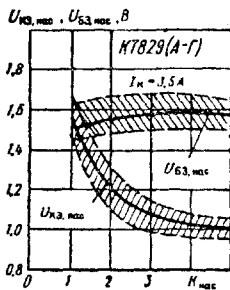
Входные характеристики



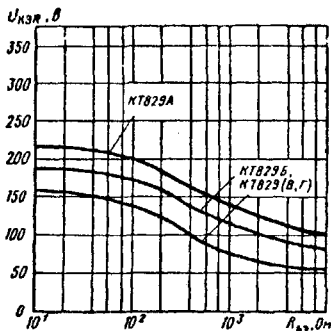
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



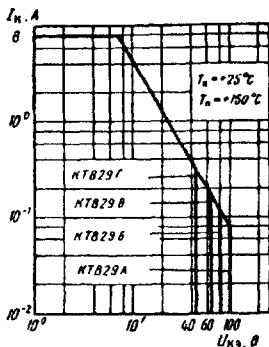
Зона возможных положений зависимости обратного тока коллектора от температуры



Зона возможных положений зависимостей напряжений насыщения коллектор — эмиттер и база — эмиттер от коэффициента насыщения



Зависимости постоянного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



Области максимальных режимов